



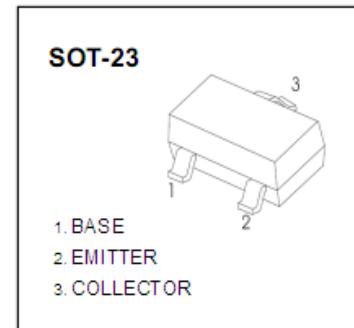
SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors**2SA812 (PNP)****特点/Features :**

- 1、 h_{FE} 高 , $h_{FE}=200$ (TYP) $V_{CE}=-6V, I_C=-1mA$;
- 2、高电压 , $V_{CEO}=-50V$;

用途/Applications :

用于一般放大，与 2SC1623 互补。

**极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^{\circ}C$)**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-60	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-50	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_c	-0.1	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_c	0.2	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	$^{\circ}C$
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}C$

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^{\circ}C$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CBO)}$	$I_c=-100 \mu A, I_E=0$	-60			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	$I_c=-1mA, I_B=0$	-50			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EBO)}$	$I_E=-100 \mu A, I_c=0$	-5			V
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-60V, I_E=0$			-0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V, I_c=0$			-0.1	μA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=-6V, I_c=-1mA$	90		600	
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_c=-100mA, I_B=-10mA$			-0.3	V
基极-发射极饱和压降	V_{BE}	$I_c=-1mA, V_{CE}=-6V$	-0.58		-0.68	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=-6V, I_c=-10mA$		180		MHz
集电极输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=10MHz$		4.5		pF

印章/Marking & h_{FE} 分档/Classification of h_{FE}

范围/Range	90~180	135~270	200~400	300~600
印章/Marking	M4	M5	M6	M7



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO., LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

典型特性曲线图/Typical Characteristics

